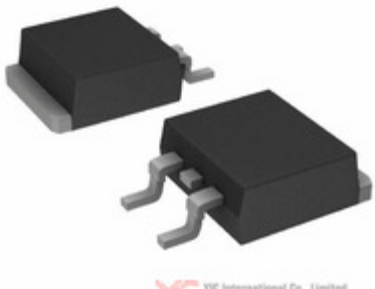



	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB083N10N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB083N10N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB083N10N3 G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 33500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB083N10N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB083N10N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.3 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB083N10N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB083N10N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB083N10N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB083N10N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB083N10N3G INFINEO IPB083N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB085N06L Infineon IPB085N06L Infineon</p>	 <p>IPB081N06LG INF IPB081N06LG INF</p>	 <p>IPB080N06NG VB IPB080N06NG VB</p>
 <p>IPB085N06L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>	 <p>IPB083N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB083N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 105A TO263-3</p>	 <p>IPB081N06L3G INF IPB081N06L3G INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB083N10N3 G International Rectifier	IPB083N10N3 G Datenblatt	IPB083N10N3 G-Datenblätter	IPB083N10N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB083N10N3 G
IPB083N10N3 G Electronic	IPB083N10N3 G-Komponenten	IPB083N10N3 G-Verteiler	IPB083N10N3 G-Bild	IPB083N10N3 G-Teil
IPB083N10N3 G Preis	IPB083N10N3 G Hersteller	IPB083N10N3 G Bild	IPB083N10N3 G Aktie	IPB083N10N3 G Inventar
IPB083N10N3 G Neu	IPB083N10N3 G Original	IPB083N10N3 G garantiert	IPB083N10N3 G RFQ	IPB083N10N3 G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited